

АУДИТОРИЯ А-402**Фундаментальные аспекты наногетероструктурной СВЧ – электроники.****Структурные свойства наносистем и гетероструктур.****Председатель секции Кульбачинский В.А.**

14:30-14:45	Гудина Светлана Викторовна	Квантовые фазовые переходы в режиме квантового эффекта Холла в системах InGaAs/InAlAs со спин-вырожденными уровнями Ландау
14:45-15:00	Грешнов Андрей Анатольевич	Квантово-механическая теория ударной ионизации в AzB_5 прямозонных полупроводниках и квантовых ямах
15:00-15:15	Афанасьев Александр Николаевич	Перспективы транзисторов с полевым контролем ударной ионизации (I-MOS) в вычислительных системах с тактовой частотой 10 ГГц и выше
15:15-15:30	Протасов Дмитрий Юрьевич	Рассеяние на деформационном потенциале и сплавном потенциале в донорно-акцепторных гетероструктурах рНЕМТ
15:30-15:45	Новиков Сергей Игоревич	Исследование уровней размерного квантования в обращенных гетероструктурах с донорноакцепторным легированием
15:45-16:00	Сафонов Данил Андреевич	Влияние донорного легирования кремнием на электронный транспорт в квантовых ямах AlGaAs/InGaAs/GaAs при различных температурах
16:00-16:15	Чернов Михаил Юрьевич	Взаимосвязь дизайна метаморфных структур с КЯ InAs/In _{0.75} Ga _{0.25} As/In _{0.75} Al _{0.25} As, выращенных методом МПЭ на GaAs, с их электрическими и оптическими свойствами
16:15-16:30	Клочков Алексей Николаевич	Распределение электронов в квазиодномерных наноструктурах на основе дельта-легированных квантовых ям InGaAs/InAlAs
16:30-17:00	КОФЕ – БРЕЙК	
17:00-17:15	Васильевский Иван Сергеевич	Электронные транспортные свойства и морфология структур с метаморфной квантовой ямой In _{0.2} Al _{0.8} As/In _{0.2} Ga _{0.8} As
17:15-17:30	Комиссаров Иван Владимирович	Исследование структуры и морфологии пленок оксида гафния осажденных на кремнии методом реактивного магнетронного распыления
17:30-17:45	Аврамчук Александр Васильевич	Локальный лазерный отжиг пленки 3C-SiC, осажденной методом ХПО на кремниевую подложку
17:45-18:00	Климов Евгений Александрович	Электрофизические и структурные свойства сверхрешеток LT-GaAs/GaAs:Si _i полученных методом МПЭ на подложках GaAs с ориентацией поверхности (100) и (111)A при низких температурах
18:00-18:15	Пушкарев Сергей Сергеевич	Исследование зависимости фотолюминесценции эпитаксиальных пленок GaAs:Si и In _{0.5} Ga _{0.5} As:Si на подложках GaAs (100) и (111)A, от температуры роста
18:15-18:30	Пашенко Александр Сергеевич	Влияние Bi на структурные и оптические свойства гетероструктур InAs/GaAs
18:30-18:45	Лютцау Александр Всеволодович	Кристаллическая структура полуизолирующего легированного углеродом буферного слоя GaN гетероструктур AlGaN/GaN/Al ₂ O ₃